

**CORRECCIÓN DE ERRORES****Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2018/1922 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso**

(Diario Oficial de la Unión Europea L 319 de 14 de diciembre de 2018)

En la página 129, en la entrada 3B001.f, puntos 3 y 4, la estructura se modifica como sigue:

*donde dice:* «3. Equipos diseñados especialmente para la fabricación de máscaras, que reúnan todas las características siguientes:

- a. Un haz de electrones, un haz de iones o un haz “láser”, enfocado y desviable, y
- b. Que posean cualquiera de las características siguientes:
  1. Un tamaño de anchura de altura media (FWHM) del haz en el impacto (spot) inferior a 65 nm y una colocación de imagen inferior a 17 nm (media + 3 sigma), o
  2. Sin uso
  3. Un error de recubrimiento de la segunda capa inferior a 23 nm (media + 3 sigma) de la máscara
  4. Equipos diseñados para el proceso de dispositivos, utilizando métodos de escritura directa, que reúnan todas las características siguientes:
    - a. Un haz de electrones enfocado y desviable, y
    - b. Que posean cualquiera de las características siguientes:
      1. Un tamaño mínimo del haz inferior o igual a 15 nm, o
      2. Un error de recubrimiento inferior a 27 nm (media + 3 sigma),

*debe decir:* «3. Equipos diseñados especialmente para la fabricación de máscaras, que reúnan todas las características siguientes:

- a. Un haz de electrones, un haz de iones o un haz “láser”, enfocado y desviable, y
- b. Que posean cualquiera de las características siguientes:
  1. Un tamaño de anchura de altura media (FWHM) del haz en el impacto (spot) inferior a 65 nm y una colocación de imagen inferior a 17 nm (media + 3 sigma), o
  2. Sin uso
  3. Un error de recubrimiento de la segunda capa inferior a 23 nm (media + 3 sigma) de la máscara
4. Equipos diseñados para el proceso de dispositivos, utilizando métodos de escritura directa, que reúnan todas las características siguientes:
  - a. Un haz de electrones enfocado y desviable, y
  - b. Que posean cualquiera de las características siguientes:
    1. Un tamaño mínimo del haz inferior o igual a 15 nm, o
    2. Un error de recubrimiento inferior a 27 nm (media + 3 sigma)».